		Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Перв. примен.			Конденсаторы		
		<i>[1</i>	K78-630B-1mκΦ±10%	1	
		<i>C2, C3, C9</i>	K78-630B-0,1mκΦ±10%	3	
		C4, C5	K50-63B-470mkΦ±10%	2	
		<i>[6</i>	K50-63B-22mκΦ±5%	1	
		<i> </i>	K78–630B–47nΦ±5%	2	
Справ. №					
			<u>Резисторы</u>		
		R1	C2-33H-0,125Bm-22к0м±5%	1	
		R2	C2–33H–0,125Bm–2,2к0м±5%	1	
		R3	С2–33H–0,125Bm–5600м±5%	1	
		R4	C2–33H–0,125Bm–18к0м±5%	1	
		R5	C2–33H–0,125Bm–1к0м±5%	1	
	•	R6	C2-33H-0,125Bm-27к0м±5%	1	
Подп. и дата		R7	C2-33H-0,125Bm-4,7к0м±5%	1	
		R8	Резистор переменный 3296W-1-101 (Bourns, CWA)	1	
		R9, R10	С2–33H–0,125Bm–2200м±5%	2	
		R11, R12	C2-33H-2Bm-0,10m±5%	2	
		R13	С2–33H–1Bm–100м±5%	1	
Инв. № дубл.			<u>Транзисторы</u>		
		VT1, VT2	2N54O1 (ON Semiconductor, США)	2	
Инв.		VT3, VT5	BD139G (ON Semiconductor, США)	2	
UHB. Nº		VT4	MJE15032G (ON Semiconductor, США)	1	
		VT6	BD14OG (ON Semiconductor, США)	1	
Взам.		VT7	TIP36CG (ON Semiconductor, CWA)	1	
		VT8	TIP35CG (ON Semiconductor, США)	1	
. и дата					
Nodn		Изм. Лист	N° докум. Подп. Дата	001 /733	
7/1.		Разраб.	Круглов В. С.		Лит. Лист Листов
№ подл.		Προβ. Δ	Геливанов К. В. УМЗЧ на биполярных транзисторах		METU IM H 3 FOUNDIA
NHB. N		Н. контр.	Перечень злементов		МГТУ им. Н. Э. Баумана Кафедра ИУ4 Группа ИУ4–73Б
		Утв.	Konunohaa		7 руппи ИЗ4-736 Фппмпт 44

Копировал

Формат

		Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
Перв. примен.	NY4. 11.03.03.21.73.14.001		<u>Разъёмы</u>			
		XS1	micro-fit 3.0 430450821 (Molex, США)	1		
		XS2, XS3	ACJS-MH (Amphenol, США)	2		
			Радиатор охлаждения HS 107–30	2		
Справ. №						
дата						
Тодп. и дата						
1//						
<i>δ</i> Ω.						
Инв. № дубл.						
ИНВ						
No						
OHD.						
Взам.						
дата						
Тодп. и дата						
100						
J.						
Инв. № подл.		 				
MB N			ИУ4.11.03.03.21.73.	ИУ4.11.03.03.21.73.14.001 ПЭЗ 2		
"		Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата	Капипавал Фармат 17.		

Копировал

Формат

A4